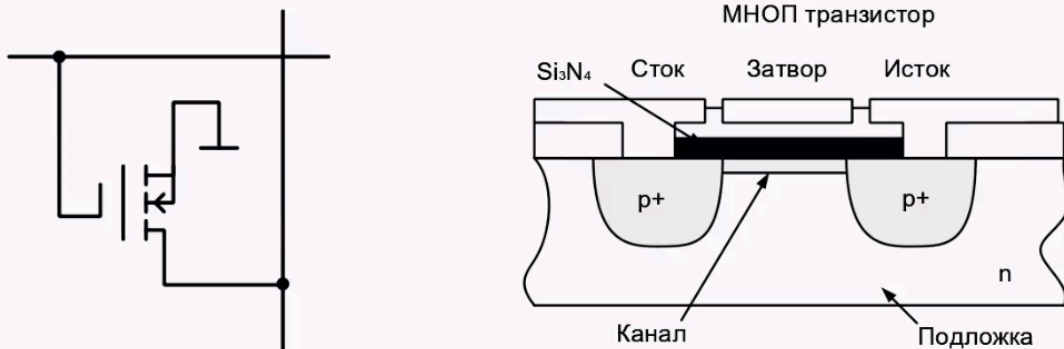


1. Элементная база РПЗУ-УФ и ОПРРПЗУ-УФ

РПЗУ-УФ, ОПРРПЗУ-УФ (EPROM, EPROM-ОТР)



РПЗУ с ультрафиолетовым стиранием

Под затвором находился «сэндвич» из двух материалов: оксид кремния и нитрид кремний - у этих материалов разная кристаллическая решетка.

На месте их соприкосновения образуется дефектная область, это является потенциальной ямой (туда попадает электрон, и он может находится там миллионы лет, пока не приложат обратный потенциал достаточный для перехода оттуда или передать туда энергию). То есть с помощью облучения ультрафиолетовой лампой удастся оттуда удалить электрон. Но это плохо сказывается на всех материалах, они разрушаются. Поэтому всего около 10 циклов записи было у такой уф флешки.